

59.

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

10 日本国特許庁 (JP)

11 特許出願公開

12 公開特許公報 (A)

昭60-10756

51 Int. Cl.
H 01 L 21/92

識別記号

庁内整理番号
7638 5F

43 公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

54 ビームリード型半導体装置の製造方法

東京都港区芝五丁目33番1号日
本電気株式会社内

21 特 願 昭58-119143

出 願 人 日本電気株式会社

22 出 願 昭58(1983)6月30日

東京都港区芝五丁目33番1号

23 発 明 者 縄巻章雄

24 代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称

ビームリード型半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

ビームリード型半導体装置の形成されたウェハ
ーを裏面してワックスで平板に貼り付ける工程と、
前記ウェハを裏面から選択的にエッチング除去
してペレットに分離する工程と、前記ワックスを
溶しペレット吸着用治具にて前記平板から前記ペ
レットを分離する工程と、前記ペレットに付着し
ているワックスを、吸められた吸着用受け皿内に
て、吸めた有機溶剤によってワックスを除去する
工程とを含むことを特徴とするビームリード型半
導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はビームリード型半導体装置の製造方法
に関する。

従来ビームリード型半導体装置の製造方法は、
所望のビームリード型半導体素子の形成された半
導体基板の上面にワックスを塗布し石英板と貼り
合せし後、該半導体基板の裏面にレジストにてパ
ターンを形成し酸液等で半導体ウ。ハを選択的
にエッチング除去してペレット状に分離し、前記
ペレット1個ずつ分けて再配列する為に100～
200℃の温度のホットプレート上でワックスを溶
しペレット吸着用治具にてペレットと石英板とを
分離後、半導体ペレットに付着ワックスを予め加
熱ヒーターで有機溶剤を吸めた有機溶剤をスプレ
ーガンで3～5分間吹付けて除去し別の配列板に
並べていた。

しかし上記従来のペレットハンドリング方法に
は、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石
英板とがワックスによって貼り合わさっており
、ワックスを100～200℃の温度のホットプレ
ート上で石英板と吸めてワックスを溶かし、ペレ
ット吸着用治具にてペレットと石英板とを分離し、

半導体ペレットの配線面及び裏面に付着しているワックスを、50～100℃の恒温範囲の加熱ヒーターにて予め有機溶剤を既めスプレーガンで吹付け時30～35秒間の有機溶剤を3～5秒間吹付けてワックスを除去し別の配列板に並べているがペレットサイズによってワックス洗浄に時間がかかりまたワックスが完全に取りきれない場合もあった。

ペレットの配線面及び裏面にワックスが残っていると、ペレットの信頼性及び歩留りを悪くし又ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄時間を長くしたりするため作業能率を悪くする欠点を持っていた。

本発明は上記欠点を除去し半導体装置の信頼性及び製造歩留りを大幅に向上させることのできる半導体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体素子の形成されたウェハを戻してワックスで平板に貼り付けする工程と、前記ウェハを裏面から選択的にエッチング除去してペレットに分離する工

- 3 -

程する。

次に図3図に示すようにペレット15の配線面及び裏面に付着しているワックス13を50～100℃恒温範囲の加熱ヒーター21によって予め有機溶剤と、洗浄用受皿18も加熱ヒーター19によって50～100℃の恒温範囲で加熱し、スプレーガン20で吹付け時35～40秒間の有機溶剤を3～4秒間吹付けてワックスを除去した後、別の配列板22上にペレット15を配列する。
(第4図)

上記のように本発明方法によればペレットの配線面及び裏面に付着しているワックスを予め既めた有機溶剤と洗浄用受皿も暖めることにより有機溶剤を両面でペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが除去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造歩留り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに關係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図面の簡単な説明

- 5 -

程と、加熱によりワックスを既しペレットを既用器具にて前記半導体からペレットを分離する工程と、前記ペレットに付着しているワックスを、既められた受皿内にて、既めた有機溶剤にて除去する工程と、前記ペレットを配列する工程とを含む半導体装置の製造方法にある。

以下本発明の好ましい実施例を参照して本発明を詳細に説明する。

まず第1図に示すように、従来のビームリード型素子の形成された半導体ウェハ1を、前記ビームリード2が下になるように裏返し、例えばスカイコートなどのワックス3を用いて石英などの平板4に貼り付ける。

次に前記半導体ウェハ1の裏面にレジストパターンを形成し、該パターンをマスクにして炭酸を既を用いて該ウェハを選択的にエッチング除去し、第2図に示すようにペレット5に分離する。次に100～200℃のホットプレート7の上で石英板4を暖めてワックス3を溶かしペレット既用器具6を用いてペレット5を石英板4から分

- 4 -

第1図乃至第4図は本発明の実施例を説明する為の断面図である。

1……半導体ウェハ、2、12……ビームリード、3、13……ワックス、4……石英板、5、15……ペレット、6、16……ペレット既用器具、7……ホットプレート、18……洗浄用受皿、19……洗浄用受皿の加熱ヒーター、20……スプレーガン、21……有機溶剤の加熱ヒーター、22……ガラス板である。

代理人 弁理士 内 原

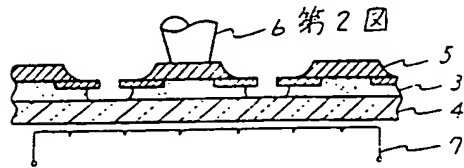


- 6 -

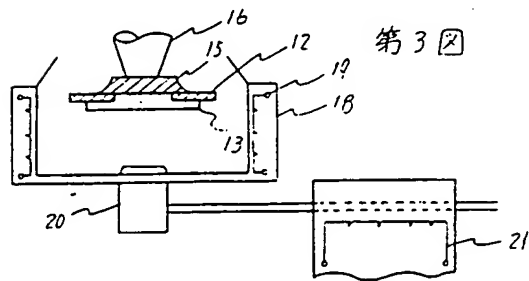
第1図



第2図



第3図



第4図

